

А. Н. ИВАЩЕНКО, д. ф.-м. н. Ю. М. ШВАРЦ,
к. ф.-м. н. М. М. ШВАРЦ

Украина, г. Киев, Институт физики полупроводников
им. В. Е. Лашкарёва
E-mail: iva@isp.kiev.ua

Дата поступления в редакцию
03.02—19.07 2005 г.

Оппонент А. Х. ДУНАЕНКО
(ОАО "Кварц", г. Черновцы)

ДИОДНЫЙ СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ: АНАЛИЗ ПРИБОРНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ

Исследование влияния составляющих погрешности измерения, связанных с используемой вторичной аппаратурой, позволило достичь прецизионной точности кремниевых диодных сенсоров температуры.

Необходимость создания нового поколения высокоточных и взаимозаменяемых широкодиапазонных датчиков температуры на основе кремниевых диодов обусловлена требованиями современной сенсорной техники, и исследования в этом направлении продолжаются [1—4]. Проведенный теплофизический расчет разработанного нами диодного сенсора температуры (ДСТ) с учетом всех его конструктивных элементов [5], а также эффекта саморазогрева чувствительного элемента датчика и влияния шумов [6], показал, что его предельная точность измерения составляет порядка 0,01 К.

Задачей данной работы является исследование влияния составляющих погрешности измерения температуры, связанных с используемой вторичной аппаратурой, для различных режимов работы сенсора.

Расчетные соотношения

Функция измерения температуры T с помощью ДСТ представляется в виде

$$T = f(U(I)), \quad (1)$$

где U — падение напряжения на термодиоде при пропускании через него прямого рабочего тока I . Такой метод проведения измерений является косвенным [7], и анализ его погрешностей проводится согласно [8].

Суммарное среднеквадратическое отклонение (СКО) измерения температуры определяем из выражения

$$S(T) = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial U}\right)^2 S^2(U) + \left(\frac{\partial f}{\partial I}\right)^2 S^2(I)}, \quad (2)$$

где частные производные функции (1) $\partial f/\partial U$ и $\partial f/\partial I$ (обозначим их k_U и k_I , соответственно) называют коэффициентами влияния составляющих погрешности измерения температуры [9, с. 20], $S(U)$ и $S(I)$ — СКО результата измерения напряжения и установки тока, соответственно.

Обозначим вклад в $S(T)$ погрешности измерения вольтметра как $S_U(T)$, а источника тока — $S_I(T)$. Тогда выражение (2) будет иметь вид

$$S(T) = \sqrt{S_U^2(T) + S_I^2(T)}. \quad (3)$$

Для исследования погрешности аппаратуры необходимо провести оценку k_U и k_I в рабочем диапазоне температур и определить максимально возможные вклады дисперсии вольтметра и источника тока в результат измерения при использовании ДСТ из выражений

$$S(U) = \frac{S_U(T)}{k_U}; \quad (4)$$

$$S(I) = \frac{S_I(T)}{k_I}. \quad (5)$$

При этом k_U и k_I определяются из выражений

$$k_U = \frac{1}{\partial U/\partial T}; \quad (6)$$

$$k_I = \frac{\partial U/\partial I}{\partial U/\partial T}, \quad (7)$$

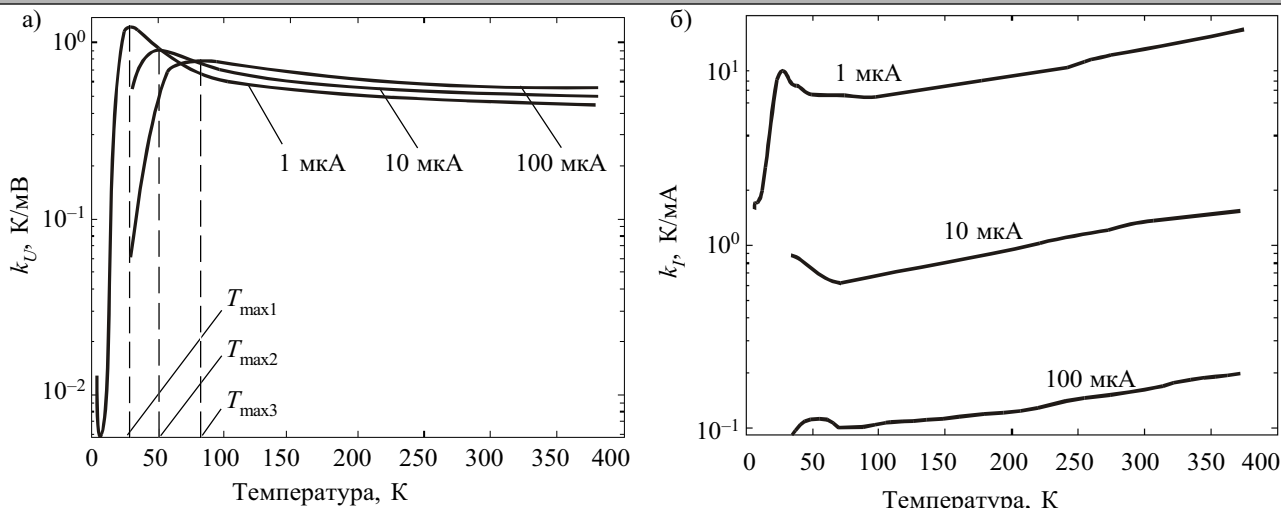
где $\partial U/\partial T$ (температурная чувствительность) и $\partial U/\partial I$ (дифференциальное сопротивление сенсора) являются температурно-зависимыми величинами.

Эксперимент

В работе исследованы разработанные нами кремниевые диодные сенсоры в диапазоне температур 4,2—373 К. Для нахождения дифференциального сопротивления на автоматизированной установке измерены вольт-амперные характеристики в интервале токов 10^{-11} — 10^{-2} А. Термостатирование образцов осуществлялось в парах жидкого гелия с погрешностью поддержания температуры $\pm 0,01$ К. Погрешность измерения напряжения в диапазоне 0,1—2 В не хуже ± 20 мкВ, тока — $\pm 5\%$.

Для определения температурной чувствительности сенсоров измерены их термометрические характеристики на метрологическом стенде УГТ-А для разных значений рабочих токов (1, 10 и 100 мкА). Стенд обеспечивает поддержание рабочего тока на уровне $\pm 0,05\%$. Погрешность измерения напряжения не хуже ± 10 мкВ в диапазоне напряжений 0,1—2 В. Основная абсолютная ошибка измерения температуры не превышала 0,03 К.

Согласно методам, изложенным в [10, 11], проведена аппроксимация и численное дифференцирование полученных экспериментальных данных и рас-



Температурные зависимости коэффициентов k_U (а) и k_I (б) при разных рабочих токах сенсора

считаны температурные зависимости чувствительности и дифференциального сопротивления.

С помощью выражений (3) и (4) получены коэффициенты k_U и k_I температурные зависимости которых представлены на рисунке.

Как видно из рисунка, для рабочих токов 1, 10 и 100 мкА коэффициент k_U имеет максимум при температурах $T_{\max 1} \approx 30$ К, $T_{\max 2} \approx 50$ К и $T_{\max 3} \approx 85$ К, соответственно. При $T < T_{\max}$ его значение резко снижается, например, до $\approx 0,006$ К/мВ для тока 1 мкА. Для $T > T_{\max}$ коэффициент k_U уменьшается с увеличением температуры. В верхней точке рабочего диапазона при $T = 373$ К величина k_U составляет 0,44, 0,48 и 0,54 К/мВ для токов 1, 10 и 100 мкА, соответственно.

Для определения требований к вольтметру зададимся максимальным значением $S_U(T)$, равным 0,01 К. В табл. 1 приведены максимальные значения коэффициента влияния точности измерения напряжения $k_{U\max}$ и допустимые значения $S(U)_{\max}$, вычисленные с помощью (4) для разных значений I . Расчет проведен исходя из величины падения напряжения на ДСТ порядка 1 В при температуре максимума k_U (см. рис.).

Таблица 1
Результаты расчета $k_{U\max}$ и $S(U)_{\max}$ при разных значениях рабочего тока сенсора

I, мкА	$k_{U\max}$, К/мВ	$S(U)_{\max}$	
		Абсолютное значение, мВ	Относительное значение, %
1	1,27	0,008	0,0008
10	0,93	0,011	0,0011
100	0,8	0,013	0,0013

Значения $k_{U\max}$, представленные в табл. 1, характерны для узкого диапазона температур $T_{\max} \pm 10$ К. При других температурах рабочего диапазона требования к $S(U)$ можно значительно снизить. Так, для тока 1 мкА в высокотемпературной области СКО измерения напряжения можно увеличить более чем в два раза без ухудшения точности измерения температуры. В интервале низких температур (4,2—15 К) $S_U(T)$ не превышает 0,01 К при $S(U) = 0,1$ мВ.

При всех использованных рабочих токах коэффициент k_I имеет максимальное значение в верхней точке рабочего диапазона температур при $T = 373$ К (см. рис.),

для которой и следует проанализировать влияние СКО установки тока на температурную погрешность ДСТ. Для оценки требований по точности установления тока задаемся максимально допустимым значением $S_I(T)$, равным 0,01 К.

Таблица 2
Результаты расчета $k_{I\max}$ и $S(I)_{\max}$ при разных значениях рабочего тока сенсора

I, мкА	$k_{I\max}$, К/мкА	$S(I)_{\max}$	
		Абсолютное значение, мкА	Относительное значение, %
1	13	$7,7 \cdot 10^{-4}$	0,077
10	1,4	$7,1 \cdot 10^{-3}$	0,071
100	0,17	$5,9 \cdot 10^{-2}$	0,059

В табл. 2 приведены предельные значения коэффициентов $k_{I\max}$ и допустимые значения СКО установления тока $S(I)_{\max}$, рассчитанные с помощью (5). Из результатов, представленных в табл. 2, следует, что значение максимально допустимого относительного значения $S(I)_{\max}$ растет с уменьшением тока.

Заключение

На основе результатов исследований электрических и термометрических характеристик разработанных нами кремниевых диодных сенсоров температуры и анализа погрешности, обусловленной влиянием источника тока и измерителя напряжения, определены требования к аппаратуре, позволяющей обеспечить точность измерения на уровне сотых долей К, которые состоят в следующем:

— для измерителя падения напряжения допустимые относительные величины среднеквадратического отклонения результата измерения напряжения $S(U)_{\max}$ составляют 0,0008, 0,011 и 0,013% для значений рабочего тока 1, 10 и 100 мкА, соответственно;

— для источника тока допустимые относительные величины СКО измерения $S(I)_{\max}$ составляют 0,077, 0,071 и 0,059% для значений рабочего тока 1, 10 и 100 мкА, соответственно.

С учетом сформулированных требований создана автоматизированная система для метрологической аттестации диодных сенсоров температуры в диапазоне 4,2—373 К. При разработке системы нами учи-

тивались новые тенденции в создании измерителей температуры, базирующиеся на возможностях современной элементной базы. Измеритель напряжения и источник тока выполнены на базе микросхем фирмы Analog Device AD7714 и AD706, соответственно. Использование микросхем аналого-цифровых преобразователей высокого разрешения (до 24 бит) типа «сигма-дельта АЦП» позволило достичь прецизионной точности диодных сенсоров температуры.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Yeager C. J., Scott C. S. A review of cryogenic thermometry and common temperature sensors // IEEE Sensors Journal.— 2001.— Vol. 1, N 4.— P. 252—360.
2. Scott C. S., Swinehart P. R., Yeager C. J. A new cryogenic diode thermometers // Advanced Advances in Cryogenic Engineering. (American Institute of Physics, NY).— 2002.— Vol. 47B.— P. 1620—1627.
3. Scott C. S., Swinehart P. R. Long-term stability of cryogenic diode // Ibid.— P. 1636—1643.
4. Шварц Ю. М., Шварц М. М., Иващенко А. Н. и др. Новое поколение микроэлектронных кремниевых термодатчиков // Технология и конструирование в электронной аппаратуре.— 2003.— № 3.— С. 59—61.

5. Круковский П. Г., Шварц Ю. М., Круковский С. П. Анализ погрешностей измерения кремниевого датчика температуры // Промышленная теплотехника.— 2002.— Т. 24, № 2—3.— С. 154—159.
6. Shwarts Yu. M., Sokolov V. N., Shwarts M. M., Venger E. F. Temperature sensors for extreme electronics / In Temperature: Its measurement and control in science and industry. AIP Conf. Proceedings. Vol. 7, part 2.— Melville, New York (USA).— 2003.— P. 1127—1132.
7. ДСТУ 2681—94. Метрологія. Терміни та визначення.— Київ: Держстандарт України, 1994.
8. МИ 2083—90 ГСИ. Измерения косвенные. Определение результатов измерения и оценивание их погрешностей.— М.: Изд-во стандартов, 1991.
9. Орнатский П. П., Яремчук Н. А. Суммирование погрешностей средств измерений.— Киев: КПИ, 1983.
10. Иващенко А. Н., Шварц Ю. М. Аппроксимация термометрических характеристик кремниевых диодных сенсоров температуры // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника.— 2003.— Вып. 38.— С. 61—70.
11. Шварц Ю. М., Шварц М. М., Иващенко О. М. та ін. Моделювання низькотемпературного струмопереносу і чутливість в кремнієвих діодних сенсорах температури // УФЖ.— 2004.— Т. 49, № 10.— С. 1001—1006.

НОВЫЕ КНИГИ

НОВЫЕ КНИГИ

Эггинс Б. Химические и биологические сенсоры.— М.: Техносфера, 2005.— 336 с.

Первое учебное пособие в новой области на стыке аналитической химии, электроники, физики и медицины. Особенно подробно описаны электрохимические, оптические, гравиметрические, температурные сенсоры, распознавание ионов и молекул, «лаборатории-на-чипе». Пособие предназначено для студентов и специалистов в областях медицинских и биотехнологий, пищевой промышленности и контроля окружающей среды, микробиологов, специалистов, разрабатывающих и применяющих микроаналитические системы.

Основы построения систем и сетей передачи информации: Учебное пособие для вузов / В. В. Ломовицкий, А. И. Михайлов, К. В. Шестаков, В. М. Щекотихин.— М.: Горячая линия-Телеком, 2005.— 382 с., ил.

Систематизированы сведения по вопросам построения современных систем и сетей передачи информации. Приведены основные положения и рассмотрены перспективы развития систем восстановления и управления единой сети электросвязи РФ, особенности построения первичных и вторичных сетей связи, цифровой сети с интеграцией служб. Рассмотрены основные подходы и методы оценки эффективности функционирования телекоммуникационных сетей общего пользования. Книга базируется на уже достаточно известных сведениях и подходах к построению систем и сетей передачи информации, а также содержит оригинальный материал по особенностям построения систем связи с повышенной устойчивостью к внешним воздействиям.

Для студентов, обучающихся по направлению 654400 — «Телекоммуникации»; может быть полезна специалистам, занимающимся эксплуатацией средств связи.

Гордиенко В. Н., Тверецкий М. С. Многоканальные телекоммуникационные системы. Учебник для вузов.— М.: Горячая линия-Телеком, 2005.— 416 с., ил.

Излагаются базовые принципы построения цифровых многоканальных телекоммуникационных систем, обсуждаются особенности работы оборудования цифровых систем передачи плезиохронной и синхронной цифровой иерархии, рассматриваются вопросы нормирования качества передачи информации по цифровым каналам и трактам, а также особенности применения цифровых систем передачи на современных телекоммуникационных сетях.

Для студентов вузов, обучающихся по специальности 201000 — «Многоканальные телекоммуникационные системы»; может быть полезен студентам, обучающимся по специальностям: 071700 — «Физика и техника оптической связи», 200900 — «Сети связи и системы коммутации», 201800 — «Защищенные системы связи».

НОВЫЕ КНИГИ

НОВЫЕ КНИГИ